高圧キセノンガス中での 紫外光に感度をもつMPPCの PDE測定

京大理 東大宇宙線研^A 東北大ニュートリノセンター^B 神戸大理^C

潘晟

市川 温子, 中家 剛, 南野 彰宏, 中村 輝石, 石山 優貴, 田中 駿祐 柳田 沙緒里, 羽田 顕人, 廣瀬 昌憲, 関谷 洋之^A, 上島考太^B, 身内賢太朗^c

> 27 Sep 2015 日本物理学会 2015年秋季大会 @大阪市立大学

Contents

- What's AXEL?
- ・真空紫外光に感度を持つMPPCの評価
- · Prototype Chamberの評価
- · Summary

Contents

- What's AXEL?
- ・真空紫外光に感度を持つMPPCの評価
- · Prototype Chamberの評価
- · Summary









Contents

• What's AXEL?

・真空紫外光に感度を持つMPPCの評価

- Prototype Chamberの評価
- · Summary

PDE measurement : Motivation

Xeの発光波長:~178 nm (真空紫外光: VUV)

現在、市販されているMPPCは感度を持たない

そこで、浜松ホトニクスがMEG実験(LXe)と共同で開発したVUV-sensitive MPPCを用いるが、ガスXe中でのPhoton Detection Efficiency (PDE)の測定はなされていない

ガス中でのこの素子のPDEを測定することは、検出器をデザインする上で非常に重要である

PDE measurement : Setup



MPPCの検出光子数 / PMTの検出光子数

→ Acceptance補正を行い、PMTをreference (QE=30%)としたMPPCのPDEを求める

68.4

0.658

35.15

1.869

600

500

400

300

200

100

PDE measurement : Update

第70回年次大会 @早稲田 (2015年3月)

- 線源の改良
 - Mono energy
 - 光量増えた



・トリガーとして3つの信号のコインシデンスを要求





PDE measurement : Result



12

Contents

- What's AXEL?
- ・真空紫外光に感度を持つMPPCの評価
- · Prototype Chamberの評価
- · Summary

2015年9月27日 JPS秋季大会@大阪市立大学

Prototype Chamber : Setup













2015年9月27日 JPS秋季大会@大阪市立大学

Prototype Chamber : Energy resolution

ProtoType3



Prototype Chamber : Energy resolution

2015年9月27日 JPS秋季大会@大阪市立大学

ProtoType3

各セル内で発生したEL光がWLSシートによって拡散され、 隣のchへの染み出しや光量のロスを引き起こす

122keV

WLSを塗布したシートに 裏からブラックライト照射 -> 210



Prototype Chamber : Energy resolution

各セル内で発生したEL光がWLSシートによって拡散され、 隣のchへの染み出しや光量のロスを引き起こす









17

2015年9月27日 JPS秋季大会@大阪市立大学

Prototype Chamber : Energy resolution



横軸にdeposit energy、縦軸にFWHM[keV]をプロット

→ FWHM =
$$a\sqrt{E} + bE$$
 でFit
 $\begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ &$

Q値(2.46MeV)への外挿

→ FWHM@2.46MeV : 3.97 %

目標のエネルギー分解能(0.5%@Q値)に比 べると1桁悪い

- VUV-sensitive MPPCに置き換える

- z fiducial cutを実装する

ことで改善が期待される



Contents

- What's AXEL?
- ・真空紫外光に感度を持つMPPCの評価
- · Prototype Chamberの評価
- · Summary

Summary

AXEL

大質量、高エネルギー分解能、トポロジーによる背景事象除去の全てを満たした 検出器開発を目指し、奮闘中

VUV-sensitive MPPCのPDE測定

前回の学会から線源とDAQ方法を改良

PDEとして8~9.5%を得た

Over voltageとPDEの間に相関は見られなかった

Prototype chamber

4.0atmのXeガス中で64chの読み出しにてデータ取得

WLSによる光の滲み出しがエネルギー分解能を悪化させている原因と考えられる

VUV-sensitive MPPCに取り替えて(11月初旬)測定予定

Back Up

Prototype Chamber : WLS-coated

WLS-sheet(アクリル板)による滲み出しを解消するために、 アクリル板を使わずにWLSを直接MPPCに塗布する

-> EL光があったと判定されるch数が減った(にじみ軽減)

-> 光量も大きくなった





2015年9月27日 JPS秋季大会@大阪市立大学

Prototype Chamber : Energy resolution

ProtoType3

Xe 4.0atm中で測定

可視光用MPPC

+ トルエンに溶かした波長変換剤(TPB) をMPPCに直塗り

⁵⁷Coからのガンマ線(122keV)を当てて エネルギー分解能を評価 -> WLS-sheetに比べ、<u>光量は増加</u> エネルギー分解能はあまり向上せず

WLS-sheetでの解析結果

Energy [keV]	29.78	33.62	88.44	92.28	122.1
Peak [photon]	4245.1	4791.4	12143.5	12479.01	6221.2
Sigma	132.1	182.6	340.5	353.1	399.2
FWHM	7.2%	8.8%	6.5%	6.6%	5.7%



Energy [keV]	29.78	33.62	88.44	92.28	122.1
Peak [photon]	7153.0	8607.4	19754.3	20160.7	27035.8
Sigma	227.5	170.1	407.9	548.3	581.2
FWHM	7.4%	4.9%	4.8%	6.2%	5.0%

Prototype Chamber : Energy resolution

2015年9月27日 JPS秋季大会@大阪市立大学



光の滲み出しはある程度解消したと思われるが……

横軸にdeposit energy、縦軸にFWHM[keV]をプロット



Summary (2)

AXEL

大質量、高エネルギー分解能、トポロジーによる背景事象除去の全てを満たした 検出器開発を目指し、奮闘中

VUV-sensitive MPPCのPDE測定

前回の学会から線源とDAQ方法を改良

PDEとして8~9.5%を得た

Over voltageとPDEの間に相関は見られなかった

Prototype chamber

4.0atmのXeガス中で64chの読み出しにてデータ取得

WLSによる光の滲み出しがエネルギー分解能を悪化させている原因と考えられる

-> WLSを1枚のシートから各MPPCに直塗りするスタイルに変えても改善せず

VUV-sensitive MPPCに取り替えて(11月初旬)測定予定

EL過程:YieldのAnode電場依存性



-> Goal: 0.5%FWHM @Q值



PDE measurement : Geometry





Type No : 3x3MM-50UM VUV3(下部) -. ch0 : A0014, Vop=55.18 V -. ch1 : A0015, Vop=54.99 V Type No : 3x3MM-100UM VUV3(上部) -. ch2 : A0006, Vop= 53.65 V -. ch3 : A0007, Vop= 53.55 V

8

ds-dady

2h

 $d\Omega = \frac{dS\cos\theta}{r^2} = \frac{1}{x^2+y^2+c^2} \times \frac{c}{\sqrt{x^2+y^2+c^2}} \times dxdy$

y a

PDE measurement : Geometry

立体角(PMT)

$$\begin{split} \Omega_{\rm PMT} &= \int d\Omega \\ &= \int \frac{dS \cos \theta}{r^2} \\ &= \int_a^{a+2b} dx \int_{-b}^b dy \frac{c}{(x^2 + y^2 + c^2)^{3/2}} \\ &= \left[\int_{-b}^b \frac{cx \, dy}{(c^2 + y^2)\sqrt{c^2 + x^2 + y^2}} \right]_a^{a+2b} \end{split}$$

$$\begin{split} \Omega_{\rm PMT} &= \left[\int_{-12}^{12} \frac{28.45x}{(28.45^2 + y^2)\sqrt{28.45^2 + x^2 + y^2}} dy \right]_{4.35}^{14.6} \\ &= \int_{-12}^{12} \frac{28.45 \times 14.6 \ dy}{(809.4025 + y^2)\sqrt{809.4025 + 213.16 + y^2}} - \int_{-12}^{12} \frac{28.45 \times 4.35 \ dy}{(809.4025 + y^2)\sqrt{809.4025 + 18.9225 + y^2}} \\ &= 2 \times 28.45 \int_{0}^{12} \frac{1}{y^2 + 809.4025} \left\{ \frac{14.6}{\sqrt{y^2 + 1022.5625}} - \frac{4.35}{\sqrt{y^2 + 828.325}} \right\} dy \\ &= 56.9 \left[14.6 \times \frac{\arctan\left(\frac{y\sqrt{213.16}}{\sqrt{809.4025}\sqrt{y^2 + 1022.5625}}\right)}{\sqrt{809.4025}\sqrt{213.16}} - 4.35 \times \frac{\arctan\left(\frac{y\sqrt{18.9225}}{\sqrt{809.4025}\sqrt{y^2 + 828.325}}\right)}{\sqrt{809.4025}\sqrt{18.9225}} \right]_{0}^{12} \\ &= 56.9(6.270 \times 10^{-3} - 2.065 \times 10^{-3}) \\ &= 0.239 \end{split}$$

PDE measurement : Geometry

立体角(MPPC)

下部に設置したMPPCの線源からみた立体角を計算する

$$\begin{split} \Omega_{\text{MPPC}} &= \int d\Omega \\ &= \int \frac{dS \cos \theta}{r^2} \\ &= \int_a^{a+2b} dx \int_{-b}^b dy \frac{c}{(x^2 + y^2 + c^2)^{3/2}} \\ &= \left[\int_{-b}^b \frac{cx \, dy}{(c^2 + y^2)\sqrt{c^2 + x^2 + y^2}} \right]_a^{a+2b} \end{split}$$

a=8.375, b=1.5, c=28.45を代入



$$\begin{split} \Omega_{\text{MPPC}} &= \left[\int_{-1.5}^{1.5} \frac{28.45x}{(28.45^2 + y^2)\sqrt{28.45^2 + x^2 + y^2}} dy \right]_{8.375}^{11.375} \\ &= \int_{-1.5}^{1.5} \frac{28.45 \times 11.375 \ dy}{(809.4025 + y^2)\sqrt{809.4025 + 129.390 + y^2}} - \int_{-1.5}^{1.5} \frac{28.45 \times 8.375 \ dy}{(809.4025 + y^2)\sqrt{809.4025 + 70.140 + y^2}} \\ &= 2 \times 28.45 \int_{0}^{1.5} \frac{1}{y^2 + 809.4025} \left\{ \frac{11.375}{\sqrt{y^2 + 938.7925}} - \frac{8.375}{\sqrt{y^2 + 879.5025}} \right\} dy \\ &= 56.9 \left[11.375 \times \frac{\arctan\left(\frac{y\sqrt{129.390}}{\sqrt{809.4025}\sqrt{y^2 + 938.7925}}\right)}{\sqrt{809.4025}\sqrt{129.390}} - 8.375 \times \frac{\arctan\left(\frac{y\sqrt{70.140}}{\sqrt{809.4025}\sqrt{y^2 + 879.5025}}\right)}{\sqrt{809.4025}\sqrt{70.140}} \right]_{0}^{1.5} \\ &= 56.9(6.870 \times 10^{-4} - 5.226 \times 10^{-4}) \\ &= 0.00935 \end{split}$$

PDE measurement : DAQ



シンチレーション光イベントとMPPC, PMTのDark current事象を切り分けるため、

PMTの信号 (×0.5) : -300 mVのThreshold MPPCの信号 (×10倍Amp) ×2個:-300 mVのThreshold のthresholdを全て超えたイベント(coincidenceイベント)をTriggerとしてデータを取得した。

MPPCへの印加電圧は55.0V, 55.5V, 56.0Vm 56.5V, 57.0Vの5通りで測定

各印加電圧でシンチレーション光イベントのデータを取得する前に、clock generatorを用いたランダムなタイミングの triggerでデータをとり、MPPCのdark currentの解析を行う

PDE measurement : Upgrades



3つの光検出器のコインシデンスを要求

シンチレーション光イベントを選択するため、
 PMTの信号 (×0.5)
 MPPCの信号 (×10倍Amp) ×2個: -300 mVのThreshold
 Othresholdを全て超えたイベント(coincidenceイベント)をTriggerとしてデータを取得した。

PDE measurement: オシロ画像



MPPCは57.0V印加

Trigger条件は前ページの通り

PMTに大きな信号が入ると、(恐らく) フラットケーブルを介してMPPCの信 号線に大きなクロストークが乗る -> クロストーク成分は、解析で積分 すると消えることを確認

PDE measurement : Digitized signal

250MHzサンプリングFADCによる波形データ(左下図)

triggerの周辺をRegion of Interest(ROI)に設定し、この範囲内でシンチレーション光イベントの解析を行う(下図)



ch3

Graph

File Edit View Options Tools

PDE measurement: Dark Current解析

解析thresholdを決めるため、各event, 各chでベースラインを計算 する

- -> 各eventの全範囲(4096sample分)のfadc値の平均をベースライン とした。また、その標準偏差 σ も求めた。
- -> さらに、上で求めたベースラインから1σ以内のfadc値だけを選び 出し、平均をとる。
- -> 解析Thresholdとしてベースラインから2.0 gのレベルを設定

dark current解析内容

- ・設定した解析thresholdを超えたら、そこからベースラインに戻るまでの間、ベースラインとFADC値との差分を足し合わせる(積分)。
 - -> 得られたヒストグラムをガウシアンフィットすることで、1p.e.のピーク位置を見つけ、その半分の値(0.5p.e.) 以上のデータをMPPCのダークカレントとする
 - -> ダークカレント(0.5p.e.以上)の積分値の平均値をeffective gainとして記録



-スライン

2σ 3σ

3000

2500

2000

1500

1000

500

1p.e.

Entrins.

RMS

69305

23.87

19.53

PDE measurement : Effective gainについて

MPPCに1photonが入射したとき、出力される信号の大きさはクロストークやアフターパルスなどの影響で必ずしも 1p.e.レベルとは限らない

-> 2p.e., 3p.e., …… レベルの信号も出力され得る

右図のように、ADC値を積分した分布の1つ目と2つ目のピークの差を1p.e. に対応する積分値とすると、上述のクロストーク、アフターパルスの影響を 考慮できていないgainとなってしまう




PDE measurement: Dark Current解析

Dark current解析の一例

MPPCへの印加電圧57.0V



PDE measurement: Dark Current解析

Bias Voltage vs. effective gainをプロットし、1次関数でフィッティング
-> effective gainが0となるときのBias VoltageをBrakedown voltageとした

Fitting結果

ch0 : (Eff_gain) = 12.72*V - 645.38 ch1 : (Eff_gain) = 20.35*V - 1071.6 スペックシート記載の値 ch0 : V₀=55.18 V ch1 : V₀=54.99 V



PDE measurement: Scintillation light解析

解析内容(MPPC, PMT共通)

baselineは1270clock~4095clock(ROIの後ろ)のFADC値の平均として求める。

MPPCの信号は、前述のノイズ(PMTの信号によるクロストーク)の影響を差し引くために、ROIの全範囲内でFADC値 とベースラインとの差を求め、全て足し合わせる。(ROIの範囲内全てにおいて積分する) -> 得られた積分値を各MPPCのeffective gainで割ることで検出光子数を算出する。

PMTについても同様に積分することで検出光子数を求める



PDE measurement: Scintillation light解析

MPPC ch0 (57.0V)



-> この値の平均値を次頁の「測定値」とする

PDE measurement: PDE算出方法

- ・ PMTの検出光子数 = 全シンチレーション光子数 * PMT方向の立体角割合 * QE
- ・MPPCの検出光子数 = 全シンチレーション光子数 * MPPC方向の立体角割合 * PDE
- ・ MPPCの検出光子数/PMTの検出光子数 = 測定値
- より、



Dark current measurement runのときのデータに対して、次の3通りでcrosstalk & afterpulse ratioを求める

- 1. (1.5 p.e. threshold dark current) / (0.5 p.e. threshold dark current)
- 2. (2 p.e.ピークのentry数) / (1 p.e. ピークのentry数)
- 3. (1.8 p.e. threshold dark current) / (0.5 p.e. threshold dark current)

2の方法についての補足:

Crosstalkが起こる確率をpとし、総dark current数をNとする。

1 p.e. レベルの信号数は N1 = N * (1-p) <- crosstalk が起こらないとき

2 p.e. レベルの信号数は N2 = Np * (1-p) <- 1回crosstalkが起こり(Np)、2回crosstalkが起こらない(1-p)とき したがって、N1/N2 = p となり、crosstalk ratioが求まる

1. (1.5 p.e. threshold dark current) / (0.5 p.e. threshold dark current)



- 2. (2 p.e.ピークのentry数) / (1 p.e. ピークのentry数)
- ・Entry数について:各ピークをガウシアンでフィッティングした後、その面積を求めることでEntry数とした
- ・1 p.e. ピークの範囲について:1p.e.イベントのピークをフィッティングによって求めた後、 0.5p.e. ~ 1.5 p.e. とした



・2 p.e. ピークの範囲について:1.5p.e. ~ 2.5 p.e. にしようとしたところ、フィッティングに失敗 -> 1.8 p.e. ~ 2.8 p.e. に設定した



2. (2 p.e.ピークのentry数) / (1 p.e. ピークのentry数)



3. (1.8 p.e. threshold dark current) / (0.5 p.e. threshold dark current)

2の方法(各ピークのentry数の比較)と条件を揃えるため、2 p.e.以上のイベントのthresholdを1.8 p.e.に設定



3手法の比較



- ・いずれの方法もCrosstalk and Afterpulse ratioが⊿Vと共に上昇する傾向が見られた
- ・1の手法(1.5p.e. thr / 0.5p.e. thr)はやや大きめの値がでた
- ・2と3の手法は、⊿Vが低いところではほとんど同じ値となった

⊿Vが高いところでは3の手法の方がcrosstalk & afterpulse ratioは大きくなった

PDE measurement : Null test



2015年9月27日 JPS秋季大会@大阪市立大学

Prototype Chamber



Prototype Chamber



Prototype Chamber : Conditions



Setup



Xe: 3.9 atm (reuse)

High Voltage

- Cathode : -6.0 kV
- Anode : -4.8 kV
- PMT : -800 V
- MPPC : -68.0 V (all ch)

Recode length

- DT5740_1 : 2001 samples (~32 us)
- DT5740_2 : 2001 samples
- v1720 : 20000 samples (200 us)

Source

- per11 : 57Co & 137Cs
- per12 : 57Co





Prototype Chamber: 収集効率





緑 : E_{anode} / E_{drift} = 4000/100 = 40 測定点:E_{anode} / E_{drift} = 9600/200 = 48

Prototype Chamber : dark解析





Prototype Chamber : dark解析





2015年9月27日 JPS秋季大会@大阪市立大学

Prototype Chamber : Gain correction



右図で黄色のMPPC chのgain補正をしたいとき

- 1. 黄色および赤色のch以外にEL hitがない
- 2. 黄色のchが一番検出光子数が多い

という条件を課し、これを満たすイベントの光子数分布を各ch毎にもとめる

-> 30keVのピークをガウシアンでフィットし、gainの補正を行う



2015年9月27日 JPS秋季大会@大阪市立大学

- EL hit factor = 5.0
- 右図の赤領域のGain correction
- Gain correctionを行うchと、その周り8ch(最外層は5ch)以外のchはveto領域とする + gain correctionを行うchが最も光っていることを要求



2015年9月27日 JPS秋季大会@大阪市立大学

- EL hit factor = 5.0
- 右図の赤領域のGain correction
- Gain correctionを行うchと、その周り8ch(最外層は5ch)以外のchはveto領域とする + gain correctionを行うchが最も光っていることを要求





- EL hit factor = 5.0



2015年9月27日 JPS秋季大会@大阪市立大学

- EL hit factor = 5.0
- 右図の赤領域のGain correction
- Gain correctionを行うchと、その周り8ch(最外層は5ch)以外のchはveto領域とする + gain correctionを行うchが最も光っていることを要求



2015年9月27日 JPS秋季大会@大阪市立大学

- EL hit factor = 5.0
- 右図の赤領域のGain correction
- Gain correctionを行うchと、その周り8ch(最外層は5ch)以外のchはveto領域とする + gain correctionを行うchが最も光っていることを要求



- EL hit factor = 5.0
- peak mapおよびratio mapがほとんど揃っている -> 1回目のEL gain補正でほとんどうまくいっている



- EL hit factor = 5.0
- peak mapおよびratio mapがほとんど揃っている -> 1回目のEL gain補正でほとんどうまくいっている



Prototype Chamber : Energy spectrum





Prototype Chamber : Energy spectrum



Prototype Chamber : Energy spectrum

2015年9月27日 JPS秋季大会@大阪市立大学

WLS sheet



線形性はちゃんとあるように見える

2015年9月27日 JPS秋季大会@大阪市立大学

Prototype Chamber : conditions



Setup

Gas

Xe: 4.00 atm (reuse)

High Voltage

- PMT : -800 V
- MPPC : -67.0 V (all ch)

Recode length

- DT5740_1 : 2001 samples (~32 us)
- DT5740_2 : 2001 samples
- v1720 : 10000 samples (100 us)

Source

- per1 : none (Cathode6.0kV, Anode4.8kV, Trigger : clock)
- per2 : none (Cathode6.0kV, Anode4.8kV, Trigger : MPPC Sum signal)
- per3 : 57Co with Pb collimator (Cathode6.0kV, Anode4.8kV)



Prototype Chamber: 収集効率

WLS coated



0 100 150 200 250

00 350 400 450 50 V_{drift}-V_{anode} [V] (d=2cm)

300

500

60^{Ei}

50

緑 $: E_{anode} / E_{drift} = 4000 / 100 = 40$ 測定点:Eanode / Edrift = 9600/200 = 48

Prototype Chamber : dark解析





Prototype Chamber : dark解析





2015年9月27日 JPS秋季大会@大阪市立大学

Prototype Chamber : Gain correction



右図で黄色のMPPC chのgain補正をしたいとき

- 1. 黄色および赤色のch以外にEL hitがない
- 2. 黄色のchが一番検出光子数が多い

という条件を課し、これを満たすイベントの光子数分布を各ch毎にもとめる

-> 30keVのピークをガウシアンでフィットし、gainの補正を行う



2015年9月27日 JPS秋季大会@大阪市立大学

WLS coated

- EL hit factor = 5.0
- 右図の赤領域のGain correction
- Gain correctionを行うchと、その周り8ch(最外層は5ch)以外のchはveto領域とする + gain correctionを行うchが最も光っていることを要求



2015年9月27日 JPS秋季大会@大阪市立大学

WLS coated

- EL hit factor = 5.0
- 右図の赤領域のGain correction
- Gain correctionを行うchと、その周り8ch(最外層は5ch)以外のchはveto領域とする + gain correctionを行うchが最も光っていることを要求


Prototype Chamber : Gain correction (1)



- EL hit factor = 5.0



Prototype Chamber : Gain correction (2)

2015年9月27日 JPS秋季大会@大阪市立大学

- EL hit factor = 5.0
- 右図の赤領域のGain correction
- Gain correctionを行うchと、その周り8ch(最外層は5ch)以外のchはveto領域とする + gain correctionを行うchが最も光っていることを要求



Prototype Chamber : Gain correction (2)

2015年9月27日 JPS秋季大会@大阪市立大学

- EL hit factor = 5.0
- 右図の赤領域のGain correction
- Gain correctionを行うchと、その周り8ch(最外層は5ch)以外のchはveto領域とする + gain correctionを行うchが最も光っていることを要求



Prototype Chamber : Gain correction (2)



- EL hit factor = 5.0



76

Prototype Chamber : Energy spectrum



Prototype Chamber : Energy spectrum



Prototype Chamber : Energy spectrum

2015年9月27日 JPS秋季大会@大阪市立大学

WLS coated



線形性はちゃんとあるように見える

Prototype Chamber : EL gain consistency

30keVのピークをつかってELgainを算出

ionization electron : 29780 eV / 22.1 eV (W-value) = 1347.5 electrons detected photon : 4691.2 photons

-> EL gain : 4691.2 / 1347.5 = 3.482

 $dN_{photon}/dz = 70(E/p-1.0)p$ にE=9.6kV/cm, p=4atmを代入 -> z=0.5cmで784photons/electron -> EL photonがMPPC側に飛ぶ:0.5, WLSによる発光がMPPC側に飛ぶ:0.5, MPPC PDE:0.3をかけると58.8



TPB塗布面

アクリル板

t1.0

Prototype Chamber : EL gain consistency

測定値

30keVのピークをつかってELgainを算出 ionization electron : 29780 eV / 22.1 eV (W-value) = 1347.5 electrons detected photon : 4691.2 photons

-> EL gain : 4691.2 / 1347.5 = 3.482

文献による見積もり

 $dN_{photon}/dz = 70(E/p-1.0)p$ にE=9.6kV/cm, p=4atmを代入 -> z=0.5cmで784photons/electron

- ELCCの構造: 収集効率12.9% (xenonwiki/Light Collection Cell/elcclightcol.pptxのスライド7)
- WLS(TPB)による変換効率:上島さんの修論によると最大で70%程度。http://www-sk.icrr.u-tokyo.ac.jp/xmass/publist/documents/Mron-f.pdf

ただし、こちらのWLSは精製方法も異なり、最適化もほとんどされていないので、 かなりover estimateになる

- アクリル板の屈折率: 1.49~1.53より全反射の臨界角は約41°

-> 全ての光がセルの中心軸上で波長変換されたと仮定すると、アクセプタンス因子は12.55% - MPPCのPDE : 0.35と過程

-> 784 * 0.129 * 0.7 * 0.125 * 0.35 = 3.097

WLSの変換効率、アクリル板による全反射の部分で over estimateしているハズなのに測定値よりも小さ い値となった



ProtoType3

光量变化: EL gain correction

20150819

- EL gainのAnode電場依存性
- -> Thresholdは文献値とコンパラ 傾きは文献値よりもだいぶ大きめ



ただし、netのEL gainから真のEL gainを求める際に、以前の見積もりを使用した

Prototype Chamber:前回大会

前回の学会(2015年3月@早稲田)で発表したエネルギースペクトル(中村が発表)



20150826-20150827

E_drift : 200.0 V/cm (E/p : 50.0 V/cm/atm)











20150826-20150827/per6 Cathode : -6.0kV Anode : -4.8kV



ドリフト速度の決定



目でみてedgeを判断 -> 最大ドリフト距離(6.5cm)に対応 -> Drift速度の算出

20150826-20150827

ProtoType3

ドリフト速度の電場/圧力依存性



2015年 月 日

20150826-20150827



ドリフト速度の電場/圧力依存性



data set



WLS-sheet : 20150713_2.1b			• 解析条件	
4.0 atm Xe (reuse)			Fidcut 1	
Cathode : 6.0 kV			EL gain correction 1 * 2	
Anode : 4.8 kV			all sum 1	
MPPC : -67.0V			threshold factor 4.5	
			PMT coincidence 0	
			saturation 1	
		条件同じ		
		(WLS以外)		
WLS-coated : 20150814_2.1b			Fidcut 1	
			EL gain correction 1 * 2	
4.0 atm Xe (reuse)			all sum 1	
			threshold factor 2.0	
Anode : 4.8 KV	/		PMT coincidence 0	
MPPC:-67.0V	/		saturation 1	
	/		:	